



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 55087434 A

(43) Date of publication of application: 02.07.80

(51) Int. Ci

H01L 21/30

(21) Application number: 53163168

(22) Date of filing: 26.12.78

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

NAKAGAWA TAKAYUKI

OSHIO SHUZO

(54) ANTISTATIC METHOD AT ELECTRON BEAM EXPOSURE

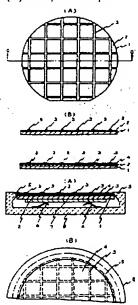
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the surface of an insulating layer on a semiconductor substrate from being electrically charged when it is subjected to electron beam exposure for forming a patten thereon, by providing beforhand a grounded reticulate conductive pattern on the mentioned surface.

CONSTITUTION: An insulating layer 2 consisting of PSG to be used for multilayer interconnection or SiO2 is fixed on a Si substrate on which a LSI element is formed by a wafer process. A reticulate conductive pattern 3 of Au, Al or Cr is formed on the layer 2 by sputtering such that the pattern 3 corresponds to a chip isolation layer provided on a substrate 1. A resist film 4 is then coated on the whole surface of the substrate 1, and the resulting substrate 1 is set in a substrate support 8, which has a substrate urging plate 7, of an electron beam exposure device such that the substrate 1 is held in the support 8 via a substrate fixing portion 5 thereof and springs 6. Thus, the film 4 is destoryed by the fixing portion 5 to allow the pattern 3 to come into contact with the grounded support 8. When electron beam exposure is conducted in the above manner,

electric charge occurring in the vicinity of the layer 2 escapes to the ground so that the electron beam is never deflected in the vicinity of the substrate 1.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55—87434

⑤Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6741-5F 砂公開 昭和55年(1980)7月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

匈電子ビーム露光に於ける帯電防止方法

2)特

類 昭53—163168

22)H

願 昭53(1978)12月26日

⑩発 明 者 中川隆行

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑫発 明 者 大塩修三

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

の出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 細 書

1. 発明の名称

電子ピーム電光に於ける帯電防止方法

2. 特許請求の範囲

半導体基板上に形成せしめた絶録層に対し、電子ビーム電光によりバターンを形成せしめるに際して、前配絶録層表面に導電性物質による網目状の導電性パターンを形成し、該導電性パターンを接地せしめるととを特徴とする、電子ビーム電光に於ける帝電防止方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体基板上に形成せしめた絶録層に 対して、電子ピーム電光によりパターンを形成せ しめる方法の改良に関するものである。

半導体装置の製造において、LSI等のように 極めて数細な電極或るいは配線パターンを形成す るに際しては、通常電子ビーム電光による方法が 行われている。

然して多層配線等の形成に於いては、半導体基 板上に形成せしめた絶義層に対するパターン形成 を電子ビーム電光によって行うが、従来眩絶縁層 に対するパターン形成に際しては、絶縁層上に直 接強布したレジスト展を電子ビーム第光により感 光せしめてパターンニングする方法が用いられて いた。

然しこの従来方法によると、半導体基板上のレジスト展が放レジスト展下部の絶録層により露光 装置の高板固定台から電気的に完全に絶縁されているため、電子ピームの衝撃によりレジスト展や 絶録層の表面附近に部分的に発生した電荷はその ままレジスト展内或いは、絶縁層表面附近に され、数電荷により部分的に生じた電位により電 され、数電荷により部分的に生じた電位により電 子ピームは半導体基板附近で偏向せしめられるの で、誤光バターンの精度が悪くなるという問題が あった。

本発明は上記問題点に鑑み半導体基板上に形成 せしめた絶縁層の電子ピーム第光に際してレジス ト膜及び絶縁層表面の帯電を防止せしめることを 目的とするものである。

即ち本発明は半導体基板上に形成せしめた絶縁

- 2 -

層に対し、粒子ピーム露光によりパターンを形成せしめるに際して、前配絶縁層表面に帯電防止のために導電性物質による網目状の導電性パターンを形成せしめることを特徴とする。

以下本発明を図に示した実施例について詳細に 説明する。

第1図はLSI製造の駅の本発明の一実施例の上面図(A)とaーa'面断面図(B)であるが、第1図 (B)に示したようにウェーハブロセスによりLSI (基子の形成を完了したシリコン基板1上に多層配 (数等の目的によりPSG, 又はSiOi等により 2 μ を 後度の厚さの絶縁層 2 を形成せしめた被処理 基板の、前配シリコン基板に予め形成されている、チップ分離層上に第1図(A)に示したように蒸着皮 るいはスパッタリング等の方法により、金, アルミニゥム, クロム等により幅10 μ = 厚さ0.5μ = 個度の網目状の導電性パターン3を形成 型に示したように該接着処理基板上にレジスト 優4を強布して後、該接処理基板を例えば第3図(A)の基板間

- 3 --

メーンを形成せしめる際には総べて有効である。

以上説明したように本発明の方法によれば、要面に高比抵抗の絶象層を有せしめた半導体基板に対する電子ビーム電光によるパターン形成に際して、半導体基板の帯電を防止せしめることができるので、数半導体基板上に登細な電極或るいは配銀パターンを正確に形成せしめることができ、半導体装置の製造歩曾りの向上に極めて有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の上面図及び断面図、第 2図はレジスト膜被着基板断面図、第3図は基板 固定台断面図である。

図に於いて

1.はシリコン基板 2.は鉛級層

3.は導電性パターン 4.はレジスト展

5.は基板固定部

6.はスプリング

7.は基板押し板

8.杜基板固定台

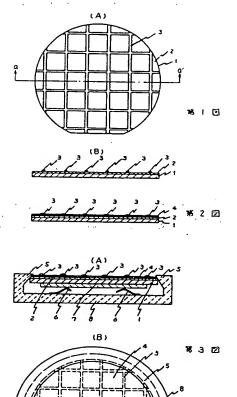
代理人 弁理士 松 岡 宏四郎

定台断面図に示したように基板固定部5とスプリング6を介して基板押し板7を有する電子ビーム 電光装置の基板固定台8にはさみ込んで固定し第 光を行う。

この際第3図個に示したように被処理基板に強布されているレジスト級4は数が板の端面に於いて基板固定部5にあたって破壊され、数端面に於いて被処理基板に形成せしめてある。 る本発明による導電性パターン3は基板固定れたの会別による導電性パターン3は基板地ではありに等通せしめられ、接地では発生の変面が近に発生した。 で数で、数値を発展2の姿面が近に発生したない。 とではがされ、被処理基板としたではできませんができません。 をでいることがなくなりで処理基板附近での電子としたの個向は起らない。

上配実施例はシリコン基板を用いたLSIの製造について説明したが、本発明の方法は能ての半 海体基板上に形成せしめた権々の高比抵抗を有す る絶縁層に対し、電子ビーム露光により欲細なパ

٠.



-5-